

1. Solid-State Electron, nr. 7, v. 38, 1995, ho0 Wen-Jeng, Dai Ting-Arn, Chuang Zuon-Ming, Lin Wei, Tu Yuan-Kuang, Wu Meng Chyi, "InGaAs PIN photodiodes on semiinsulating InP substrates with bandwidth exceeding 14 Ghz", p. 1295-1298
2. Appl. Phys. Lett, nr. 19, v. 60, 1992, I. Grave, A. Shakouri, N. Kuze, A. Yariv, "Voltage-controlled tunable GaAs/AlGaAs multistack quantum well infra-red detector", p. 2362-2364
3. Documentele conferinței "Cercetări în optoelectronică", 1994, București, V. Dorogan, V. Brânzari, A. Snigur, G. Corotcencov, V. Ceseac. Aspecte tehnologice în confecționarea fotodiodelor selective optimizate pentru $\lambda=1,06\mu\text{m}$, p. 260-266
4. MD 876 G2, 1997.11.30